- 1) Em certas transições entre níveis de energia das órbitas no hidrogênio obtem-se fótons de radiação visível (400 a 600nm). Quais são estas transições? Sugestão: começar com a energia de ionização (n, ∞).
- 2) Calcule as radiações que correspondem a energia de formação do par elétronlacuna (E_G, 1,1eV) e de ionização de impurezas (E_i, 100 meV) e compare com a faixa visível da radiações eletromagnéticas.
- 3) Calcule a concentração de elétrons livres e lacunas num cristal de silício com N_A no valor de 10¹⁶ cm⁻³, a 290 K; calcule em seguida a resistividade deste material.
- 4) Numa chave digital MOS, do tipo canal N, a concentração de elétrons no canal é, em média, 10¹⁷ cm⁻³ (V_{PS}>V_{TH}). Calcule a resistência elétrica do canal, supondo uma espessura de 0,05μm e escolhendo as outras dimensões (largura e comprimento do canal).
- 5) Descreva (qualitativamente) no que consistem as condições de Boltzmann na análise de uma junção PN.

E_f (energia de cada fóton) = h ν (freqüência da radiação)

$$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4,14 \cdot 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s} \qquad (1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}) \qquad c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$E_f = m_f c^2 \qquad \qquad \Box m_f = E_f / c^2 \qquad \qquad r_n = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m_0 q^2}$$

$$p_f = m_f c = E_f / c = h \nu / c \qquad \qquad \Box \ p_f = h / \lambda$$

$$m_0 = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{kg}$$
 $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$ $E_n = \frac{-0,5}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r_n}$

$$\lambda_e = h / p_e$$
 $E_{cin} = -0.5E_{pot}$ $m = m_0/(1-v^2/c^2)^{1/2}$

 ε_r tem o valor de 12 para o silício monocristalino $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$

E_{th}=3/2·kT (k é a constante de Boltzmann, 1,38·10⁻²³J/K)

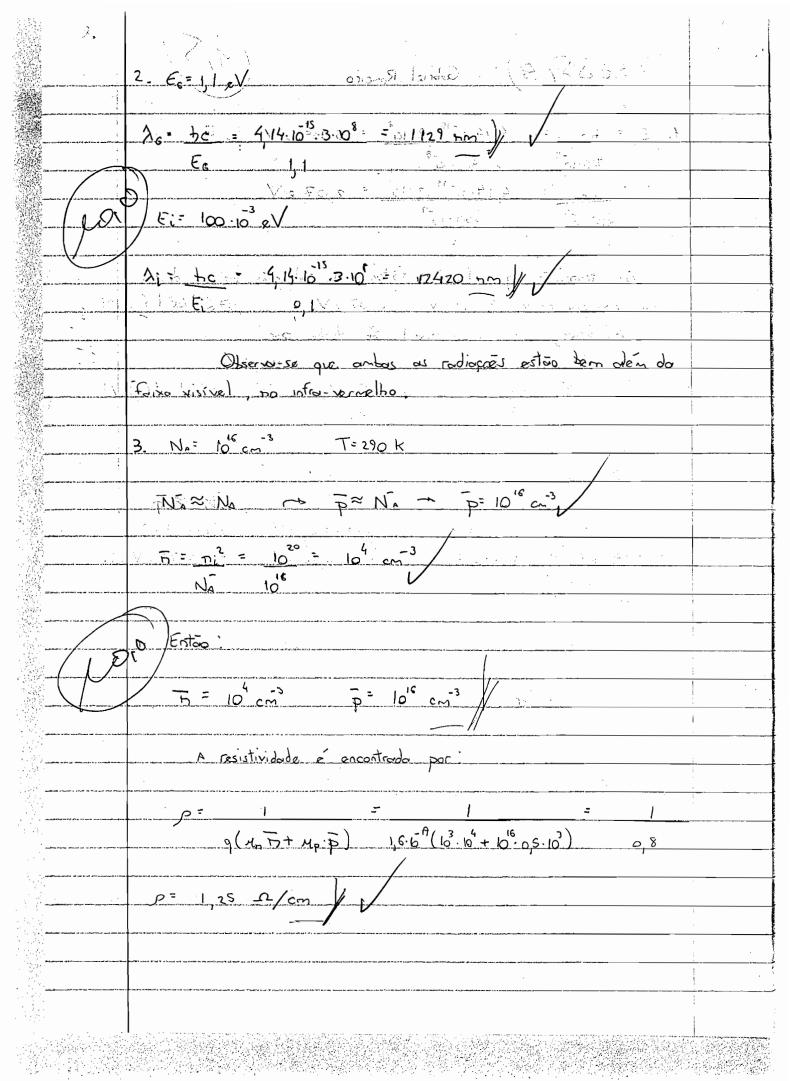
Luz visível: 400 a 600nm (
$$\lambda$$
) kT/q (290K) = 25 mV

$$\bar{n} \cdot \bar{p} = n_i^2 (T)$$
 $n_i^2 (T) = A \cdot T^3 \cdot \exp(-E_G/kT)$ $n_i^2 (290 \text{ K}) = 10^{20} \text{ cm}^{-6}$

$$\overline{p}_P = \frac{N_A^*}{2} + \sqrt{\frac{N_A^{*2}}{4} + {n_i}^2} \qquad \overrightarrow{J}_{nDER} = -q \cdot \overrightarrow{v}_n \cdot \overrightarrow{n} = q \cdot \mu_n \cdot \overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{E} \qquad \rho = R \cdot (\Delta x \cdot W) \ / \ L$$

$$\sigma \; (condutividade) = \; \frac{J_{DER}}{E} \; = q \; (\mu_n \, \overline{n} + \mu_p \, \overline{p}) \qquad \quad \mu_n = 10^3 \; cm^2 / (V \cdot s) \; \; [\mu_p \; a \; metade \; disto] \; \label{eq:sigma}$$





A chave está polarizada no inversas. Podo-se considerar que não bá lacunas na região do canal: Q M. T 1,6.10.103.1017 Tat A resistência do conal suposto é R= 125 ka 5. As condições de Bottzmano basicamente definem que as correctes de difusão na junção se anulam com as correcter de deriva gerados no bipolo, sem polaritogão externa, fazando com que rão tojo correcte em qualquer porto do bipolo. As correntes de ditusão citados surgem graças as diferenças de concentração nos dois lados de junção. Enquesto a parte N tem Delétrons livres sobrando, a parte P ten lacuras en excesse d A corrente de difusão é entro formada en parte pelo novinento de eletrons de N para P (corrente de 7 para N) e outre parte pelo movimento de bouras de P para N (corrento de P para N) V Essas correctes de difusão têm seu efecto apulado por correntes de deriva no sentido de N poro P, priundas de um compo elétrico consado por diferenças de potencial no material Na no material P. O desente no prigina seguitto ilistra a sturção Dasa marcia portante, a junção PN se muntem Deutra. C